

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Лагов Петр Борисович
2	Дата рождения (полная)	27 июня 1973 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, специальность – 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент по кафедре
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 russianspacesystems.ru contact@spacecorp.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научный центр сертификации элементов и оборудования
	Должность	Начальник отдела
7	Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. A.Y. Polyakov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, N.B. Smirnov, A.V. Chernykh, E.B. Yakimov, P.B. Lagov et al. "1 GeV proton damage in β-Ga₂O₃" J. Appl. Phys. J. Appl. Phys. 130, 185701 (2021) 2. V.M. Kasimova, N.S. Kozlova, O.A. Buzanov, E.V. Zabelina, P.B. Lagov et al. "Effect of Electron Irradiation on the Optical Properties of Gadolinium-Aluminum-Gallium Garnet Crystals" J. Surf. Investig. 15, 6 (2021) 3. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, A.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. "Crystal orientation dependence of deep level spectra in proton irradiated bulk β-Ga₂O₃" J. Appl. Phys. 130, 035701 (2021) 4. A.Y. Polyakov, C. Haller, R. Butte, N.B. Smirnov, L.A. Alexanyan, A.I. Kochkova, S.A. Shikoh, I.V. Shchemerov, A.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. "Deep Traps in InGa_N/Ga_N Single Quantum Well Structures Grown With and Without InGa_N Underlayers" J. Alloys Compd. 845, 156269 (2020) 5. L.A. Aslanov, V.B. Zaytsev, V.N. Zakharov, I.K. Kudryavtsev, V.M. Senyavin, P.B. Lagov et al. "Nanosilicon stabilized with ligands: effect of high-energy electron beam on luminescent properties" Surf Interface Anal 52,12 (2020) 6. A.Y. Polyakov, C. Haller, R. Butte, N.B. Smirnov, L.A. Alexanyan, A.S. Shikoh, I.V. Shchemerov, S.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. "Effects of 5 MeV Electron Irradiation on Deep Traps and Electroluminescence from Near-UV InGa_N/Ga_N Single Quantum Well 	

Light-Emitting Diodes With and Without InAlN Superlattice Underlayer” J. Phys. D **53**, 445111 (2020)

7. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, E.B. Yakimov, A.V. Chernykh, A.I. Kochkova, P.B. Lagov et al. “Pulsed fast reactor neutron irradiation effects in Si doped n-type β -Ga₂O₃” J. Phys. D **53**, 274001 (2020)
8. A.Y. Polyakov, C. Haller, N.B. Smirnov, A.S. Shiko, I.V. Shchemerov, S.V. Chernykh, L.A. Alexanyan, P.B. Lagov et al. “Effects of InAlN underlayer on deep traps detected in near-UV InGaN/GaN single quantum well light-emitting diodes” J. Appl. Phys. **126**, 115708 (2019)
9. P.B. Lagov, V.M. Maslovsky, Yu.S. Pavlov, E.S. Rogovsky, A.S. Drenin, V.A. Bondariev. “High-Rate High-Density ICP Etching of Germanium” High Temp. Mater. Process. **23**, 1 (2019)
10. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, S.J. Pearton, F. Ren, A.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. “Hole traps and persistent photocapacitance in proton irradiated β -Ga₂O₃ films doped with Si” APL Mater. **6**, 096102 (2018)
11. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, E.B. Yakimov, S.J. Pearton, C. Fares, J. Yang, F. Ren, J. Kim, P.B. Lagov et al. “Defects responsible for charge carrier removal and correlation with deep level introduction in irradiated β -Ga₂O₃” Appl. Phys. Lett. **113** (9), 092102 (2018)
12. A.Y. Polyakov, N.M. Shmidt, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, E.I. Shabunina, N.A. Tal’nishnih, P.B. Lagov et al. “Defect States Induced in GaN-Based Green Light Emitting Diodes by Electron Irradiation” ECS J Solid State Sci Technol **7**, 6 (2018)

Все перечисленные публикации подготовлены по результатам исследований, проведенных на кафедре Полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС» и в Лаборатории радиационных технологий ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты